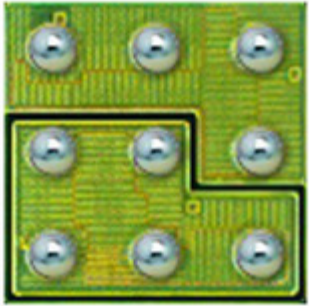




Hersteller-Teilenummer:

EPC2106ENGRT

Hersteller / Marke:

EPC

Teil der Beschreibung:

TRANS GAN 2N-CH 100V BUMPED DIE

Datenblätter:

 [EPC2106ENGRT.pdf](#)

RoHs Status:

Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand:

New original, 2697 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer	EPC2106ENGRT
Hersteller	EPC
Beschreibung	TRANS GAN 2N-CH 100V BUMPED DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2697 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 600µA
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	eGaN®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	70 mOhm @ 2A, 5V
Leistung - max	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	75pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.73nC @ 5V
Typ FET	2 N-Channel (Half Bridge)
FET-Merkmal	GaNFET (Gallium Nitride)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.7A

Sie können auch interessiert

sein:



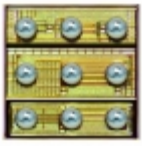
EPC2105ENG
EPC
TRANS GAN 2N-CH 80V BUMPED
DIE



EPC2110
EPC
MOSFET 2NCH 120V 3.4A DIE



EPC2107
EPC
MOSFET 3 N-CH 100V 9BGA



EPC2107ENGRT
EPC
TRANS GAN 3N-CH 100V BUMPED
DIE



EPC2105ENGRT
EPC
MOSFET 2NCH 80V 9.5A DIE



EPC2106
EPC
TRANS GAN SYM 100V BUMPED
DIE



EPC2105
EPC
TRANS GAN ASYMMETRICAL
HALF BRID



EPC2108
EPC
MOSFET 3 N-CH 60V/100V 9BGA

EPC2106ENGRT Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

EPC2106ENGRT	EPC2106ENGRT Datenblatt	EPC2106ENGRT-Datenblätter	EPC2106ENGRT PDF	EPC EPC2106ENGRT
EPC2106ENGRT Electronic	EPC2106ENGRT-Komponenten	EPC2106ENGRT-Verteiler	EPC2106ENGRT-Bild	EPC2106ENGRT-Teil
EPC2106ENGRT Preis	EPC2106ENGRT Hersteller	EPC2106ENGRT Bild	EPC2106ENGRT Aktie	EPC2106ENGRT Inventar
EPC2106ENGRT Neu	EPC2106ENGRT Original	EPC2106ENGRT garantiert	EPC2106ENGRT RFQ	EPC2106ENGRT Online bestellen